

SOT223 NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER DARLINGTON TRANSISTORS

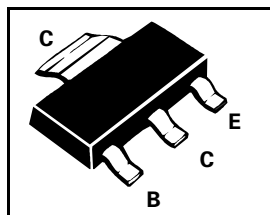
ISSUE 4 - MARCH 2001

FEATURES

- * Guaranteed h_{FE} Specified up to 2A
- * Fast Switching

PARTMARKING DETAIL - FZT605

COMPLEMENTARY TYPES - FZT705



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	140	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	120	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	10	V
Peak Pulse Current	I_{CM}	4	A
Continuous Collector Current	I_C	1.5	A
Power Dissipation	P_{tot}	2	W
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +150	°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}C$ unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	140		V	$I_C = 100\mu A$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	120		V	$I_C = 10mA^*$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	10		V	$I_E = 100\mu A$
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}		0.01 10	μA μA	$V_{CB} = 120V$ $V_{CB} = 120V, T_{amb} = 100^{\circ}C$
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}		0.1	μA	$V_{EB} = 8V$
Collector-Emitter Cut-Off Current	I_{CES}		10	μA	$V_{CES} = 120V$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		1.0, 1.5	V V	$I_C = 250mA, I_B = 0.25mA^*$ $I_C = 1A, I_B = 1mA^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$		1.8	V	$I_C = 1A, I_B = 1mA^*$
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$		1.7	V	$I_C = 1A, V_{CE} = 5V^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	2K 5K 2K 0.5K	100K		$I_C = 50mA, V_{CE} = 5V$ $I_C = 500mA, V_{CE} = 5V^*$ $I_C = 1A, V_{CE} = 5V^*$ $I_C = 2A, V_{CE} = 5V^*$
Transition Frequency	f_t	150		MHz	$I_C = 100mA, V_{CE} = 10V$ $f = 20MHz$
Input Capacitance	C_{ibo}	90 Typical		pF	$V_{EB} = 500mV, f = 1MHz$
Output Capacitance	C_{obo}	15 Typical		pF	$V_{CB} = 10V, f = 1MHz$
Switching Times	t_{on} t_{off}	0.5 Typical 1.6 Typical		nsec nsec	$I_C = 500mA, V_{CE} = 10V$ $I_{B1} = I_{B2} = 0.5mA$

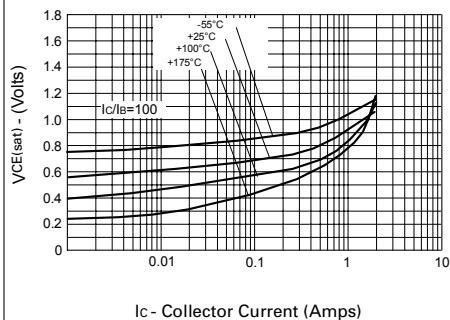
* Measured under pulsed conditions. Pulse width = 300 μs . Duty cycle 2%

Spice parameter data is available upon request for these devices.

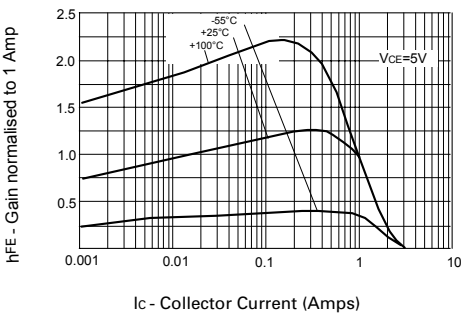


FZT605

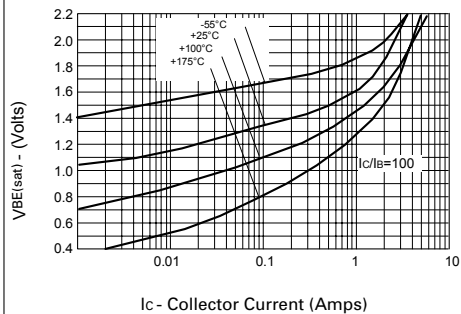
TYPICAL CHARACTERISTICS



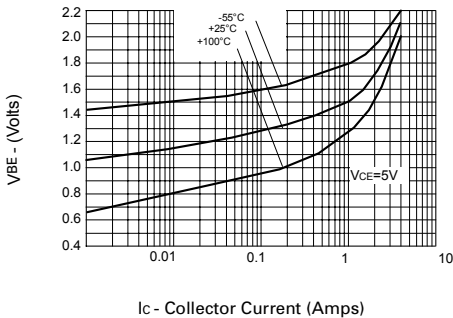
VCE(sat) v IC



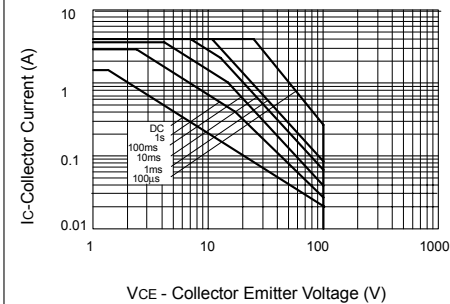
hFE v IC



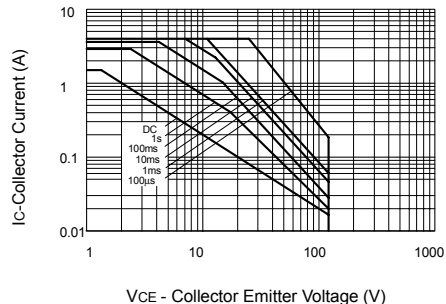
VBE(sat) v IC



VBE(on) v IC



FZT604 Safe Operating Area



FZT605 Safe Operating Area





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.